



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21), (22) Заявка: 2003121602/28, 16.07.2003

(43) Дата публикации заявки: 27.01.2005 Бюл. № 3

Адрес для переписки:

105187, Москва, Окружной пр-д, 27, ГУП НПП
"Пульсар", Нач. ПИЛ Е.П. Цыбиной

(71) Заявитель(и):

Государственное унитарное предприятие
"Научно-производственное предприятие
"Пульсар" (RU)

(72) Автор(ы):

Рогов Владимир Викторович (RU),
Константинов Петр Борисович (RU)

(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР

Формула изобретения

Способ изготовления полупроводниковых структур, включающий формирование, по крайней мере, двух структур на полупроводниковой пластине с реперными знаками для разделения, фиксацию на носителе, утонение нерабочей стороны структур путем механической обработки, резку на отдельные структуры по реперным знакам, отличающийся тем, что в качестве носителя используют кольцо с внутренним диаметром

$$D_{\text{вн}} = (1,05 \dots 1,5)(a^2 + b^2)^{1/2},$$

где а и b - соответственно габариты структуры, м, проводят резку полупроводниковой пластины по реперным знакам на отдельные структуры, каждую структуру калибруют до диаметра, равного внешнему диаметру кольцевого носителя $D_{\text{внеш}} \leq S_p$, где S_p - расстояние между реперными знаками, м, фиксируют на носителе.